

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年1月8日(2009.1.8)

【公表番号】特表2008-526019(P2008-526019A)

【公表日】平成20年7月17日(2008.7.17)

【年通号数】公開・登録公報2008-028

【出願番号】特願2007-548229(P2007-548229)

【国際特許分類】

H 05 K 3/38 (2006.01)

H 05 K 1/03 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/38 A

H 05 K 1/03 6 7 0 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年11月13日(2008.11.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板、

前記基板上に配置され、少なくとも約10.0原子百分率のケイ素を含むプラズマ蒸着層、及び

前記プラズマ蒸着層より上に配置されたパターン化導電層、  
を含む電子回路製品。

【請求項2】

ポリイミド基板、

前記ポリイミド基板上に配置され、少なくとも約50.0原子百分率の有機ケイ素化合物を含む気体から誘導されているプラズマ蒸着層、

及び前記プラズマ蒸着層より上に配置されたパターン化導電層、  
を含む電子回路製品。

【請求項3】

前記プラズマ蒸着層が、約0.5ナノメートルから約10.0ナノメートルの範囲の厚みを有する、請求項1または2に記載の電子回路製品。

【請求項4】

前記厚みが約1.0ナノメートル～約5.0ナノメートルである、請求項1または2に記載の電子回路製品。

【請求項5】

プラズマ蒸着により基板上にケイ素含有層を形成させる工程、  
前記ケイ素含有層より上に導電性材料の層を被着させる工程、及び  
前記導電性材料層をパターン化する工程、  
を含む、電子回路製品の形成方法。

【請求項6】

約0.5ナノメートルから約10.0ナノメートルまでの範囲の厚みを有する前記ケイ素含有層を提供するのに有効な曝露時間、前記基板をプラズマに対し曝露する工程をさらに含む、請求項5に記載の方法。

**【請求項 7】**

約1.0ナノメートルから約5.0ナノメートルまでの範囲の厚みを有する前記ケイ素含有層を提供するのに有効な曝露時間、前記基板をプラズマに対し曝露する工程をさらに含む、請求項6に記載の方法。